

格子像

透過関数

球面収差および焦点外れによる位相変化

 χ (hk) =2 π ($C_s \alpha^4/4 - \Delta f \alpha^2/2$)/ λ C_s : 球面収差係数、 α : ビームの1/2開き角、 Δf : 試料の焦点面からのずれ量、 λ : 波長

透過関数のフーリエ変換

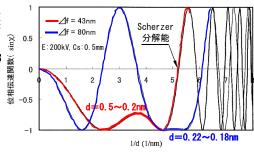
回折像

 χ (hk) による後焦点面上での弱位相物体近似 ϕ (hk) = Q(hk) exp $\{-i \chi$ (hk) $\}$ = $\{\delta$ (hk) $+i \sigma V$ (hk) $\}$ exp $\{-i \chi$ (hk) $\}$ 位相コントラスト伝達関数: I(hk) $=\exp\{-i \chi$ (hk) $\}$

海南 ノーリエ変形

φ(xy) = F(φ(hk)) = 1 + i σ V(xy) * F[exp{-i χ (hk)}]
V(xy) : 厚さΔzの範囲での平均ポテンシャル
*: コンポリューション積分

 $I(\overline{x}y) = | \varphi(xy) |^2 = 1 + 2\sigma V(xy) * F[\sin{\chi (hk)}]$



図、焦点外れによる位相コントラスト伝達関数の変化

$\Delta f = 43 nm$

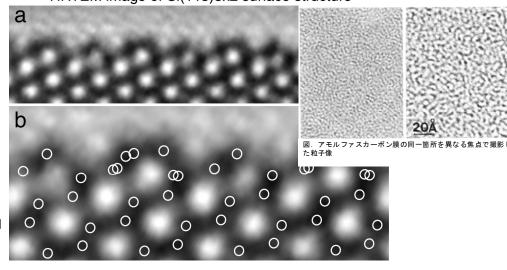
結晶構造像

多くの回折波がこの広い $sin\{x (hk)\} = -1$ の範囲に入るとすると、

 $I(\overline{xy}) = 1 - 2\sigma V(\overline{xy})$

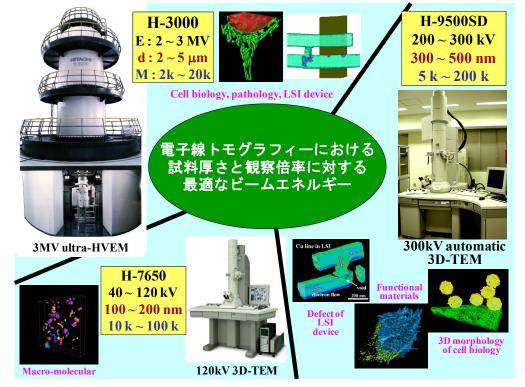
Scherzer \mathcal{I}_{π} \mathcal{I}_{π} $\Delta f = 1.2 (C_s \lambda)^{1/2}$

HRTEM image of Si(113)3x2 surface structure



真空度の高い電子顕微鏡内において、シリコンの表面を清浄化してその断面を観察した結果を示している。(b)の写真中の白い丸がシリコン原子の位置に対応している。最表面の部分においては内部とは異なる原子配列をとっていることがわかる。このような表面に出現する特異な原子配列を表面再構成構造と呼んでいる。

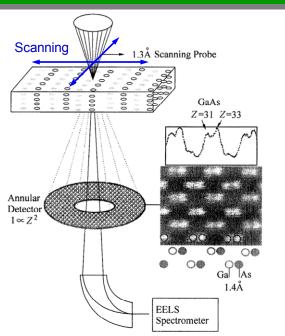
位相物体における像強度は、投影ポテンシャルと $\Gamma(hk)$ のフーリエ変換の虚数項 $(T_i(xy))$ とする) とのコンボリューションで与えられ、 $\Gamma(xy)$ というフィルター関数を介してみることに相当する。



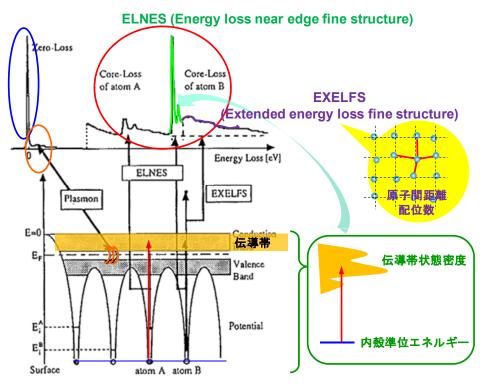
EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) Thin Foil Detection Liquid nitrogen Ultra Thin or Beryllium Fluorescience / Electrical Absorption insulator cold finger Field effect transistor X線->エネルギーに比例した電荷->電界効果トランジスタ ーン電荷量に比例したパルス電圧ーンマルチチャンネルアナラ 特性X線エネルギー 図. LSIコンタクトホールの分析例

HAADF-STEM像

(High Angle Annular Dark-Field Scanning Transmission Microscopy)



Zコントラストイメージ 原子コラム位置が常に輝 点として現れる原子直視 性がほぼ保証



代表的なEELSスペクトルとそれに対応する電子励起過程